



汕头华汕电子器件有限公司

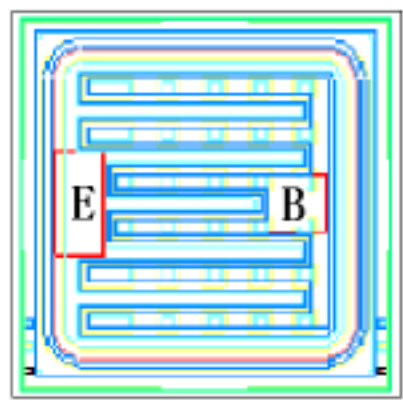
PNP SILICON TRANSISTOR

1013 晶体管芯片说明书

芯片简介

芯片尺寸：4 英寸（100mm）
芯片代码：A080BJ-01
芯片厚度：240±20μm
管芯尺寸：800×800μm²
焊位尺寸：B 极 124×124μm²；E 极 221×110μm²
电极金属：铝
背面金属：金
典型封装：2SA1013

管芯示意图



极限值 (T_a=25℃)(TO-92L)

T_{stg}——贮存温度.....-55~150
T_j——结温.....150
P_C——集电极功率耗散 (T_a=25℃).....900mW
V_{CBO}——集电极—基极电压.....-160V
V_{CEO}——集电极—发射极电压.....-160V
V_{EBO}——发射极—基极电压.....-6V
I_C——集电极电流.....-1A
I_B——基极电流.....-0.5A

电参数 (T_a=25℃)(TO-92L)

参数符号	符 号 说 明	最小值	典型值	最大值	单位	测 试 条 件
BV _{CBO}	集电极—基极击穿电压	-160			V	I _C =-100μA, I _E =0
BV _{CEO}	集电极—发射极击穿电压	-160			V	I _C =-10mA, I _B =0
BV _{EBO}	发射极—基极击穿电压	-6			V	I _E =-100μA, I _C =0
I _{CBO}	集电极—基极截止电流			-1	μA	V _{CB} =-150V, I _E =0
I _{EBO}	发射极—基极截止电流			-1	μA	V _{EB} =-6V, I _C =0
h _{FE}	直流电流增益	60		320		V _{CE} =-5V, I _C =-200mA
V _{CE(sat)}	集电极—发射极饱和电压			-1.5	V	I _C =-500mA, I _B =-50mA
V _{BE(on)}	基极—发射极电压	-0.45		-0.75	V	V _{CE} =-5V, I _C =-5mA
f _T	特征频率	15	50		MHz	V _{CE} =-5V, I _C =-200mA
C _{ob}	共基极输出电容			35	pF	V _{CB} =-10V, I _E =0, f=1MHz